









	<h2 style="color: orange;">JAN1N5809URS</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">JAN1N5809URS</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">JAN1N5809URS.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5809URS
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5809URS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5809URS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5809URS Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5809URS E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N5807</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5814</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 20A DO203AA</p>	 <p><b>JAN1N5809US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 6A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5806US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A D5A</p>
 <p><b>JAN1N5807URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG</p>	 <p><b>JAN1N5811US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 6A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5811URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG</p>	 <p><b>JAN1N5807US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A B-MELF</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5809URS Microsemi	JAN1N5809URS Datenblatt	JAN1N5809URS-Datenblätter	JAN1N5809URS PDF	Microsemi JAN1N5809URS
JAN1N5809URS Electronic	JAN1N5809URS-Komponenten	JAN1N5809URS-Verteiler	JAN1N5809URS-Bild	JAN1N5809URS-Teil
JAN1N5809URS Preis	JAN1N5809URS Hersteller	JAN1N5809URS Bild	JAN1N5809URS Aktie	JAN1N5809URS Inventar
JAN1N5809URS Neu	JAN1N5809URS Original	JAN1N5809URS garantiert	JAN1N5809URS RFQ	JAN1N5809URS Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited